



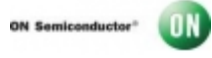

	<h2 style="color: red;">MTY100N10E</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MTY100N10E</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 100A TO-264</p> <p>Datenblätter:  MTY100N10E.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7506 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MTY100N10E
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO-264
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7506 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-264-3, TO-264AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-264
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	378nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10640pF @ 25V
Verpackung	Tube





































MTY100N10E ist neu im Original, Suche MTY100N10E Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MTY100N10E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MTY100N10E: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MTY55N20E MTP MTP TO3PL</p>	 <p>CSD2540Q3T Luminary Micro / Texas Instruments MOSFET P-CH 20V 104A 8VSON</p>	 <p>SI7407DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 9.9A PPAK 1212-8</p>	 <p>IXTC200N10T IXYS Corporation MOSFET N-CH 100V 101A ISOPLUS220</p>
 <p>MTY30N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MTY30N60E ON</p>	 <p>MTY160Y16 SEMIKRON IGBT Modules</p>	 <p>MTY30N50E ON MTY30N50E ON</p>	 <p>IPU80R3K3P7AKMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 1.9A TO251-3</p>

heiße Teile

Mehr

 04025U6R2BAT2A	 06035A330KAT4A	 06035U101JAT2A	D 0805YC104KAT4A	 12CWQ10FN
 AD1582CRT-REEL7	 AD637KQZ	D AS1301EHT-ADJ	 B340A-E3	 B78417A1847A003
 BLM18BD221SN1D	 BU9409FV	 BU94603RKV-E2	 C1608X5R1H473K080AA	 CAT5113L-00-G
D CMKD6001	 CN1005-350BG256	 CSTCR4M19G55B-R0	 CTT27GK-08	 DR3034C-B
 FDMS7556S	 GCJ31CR72E333KXJ3L	 GRM31MR72A333MA01L	 HAT2210RJ01-EL-E	 IP-2W3-EX
 IR1155SPBF	 LES25A48-3V3EJ	D LM3464MHX/NOPB	 LM4041DIM3-1.2	 LMH6628MAX/NOPB
 LT1790BCS6-3.3#TRPBF	D LT3021EDH-1.8#PBF	 MAX1701EEE	 MTY160Y16	 MTY30N50E
 MTY30N60E	 N74F194D	 PS21204-B01	 PVZ2A501C01R00	 STE36N50-DA
 T218N04TOF	 TD56N08KOF	 TFM201608GHM-R47MTAA	D TL431CDBZT	 TPA6203A1DRB
 TPS76433DBVT	 TSV6290AALT	 UCC25702PWTR	 UCC2839D	 UPG174TA-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited